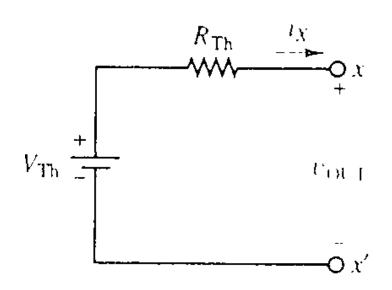
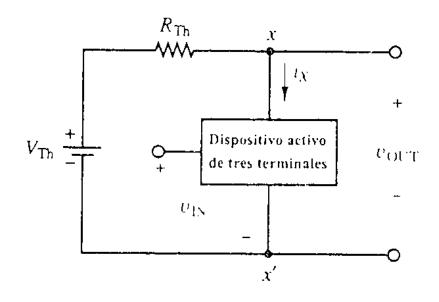
POLARIZACIÓN EN DC DE UN TRANSISTOR BJT

Polarizar un transistor consiste en suministrar las tensiones adecuadas y conectar las resistencias oportunas para que el transistor funcione dentro de los límites indicados en el diseño, de forma que la señal aplicada a la entrada no resulte deformada a la salida.

De acuerdo a cómo se lo polarice puede trabajar en tres zonas: Corte, Activa y Saturación.



$$v_{\rm OUT} = V_{\rm Th} - i_X R_{\rm Th}$$



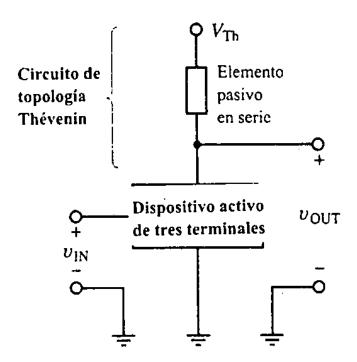
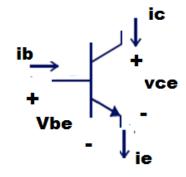


TABLA ZONAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BJT NPN



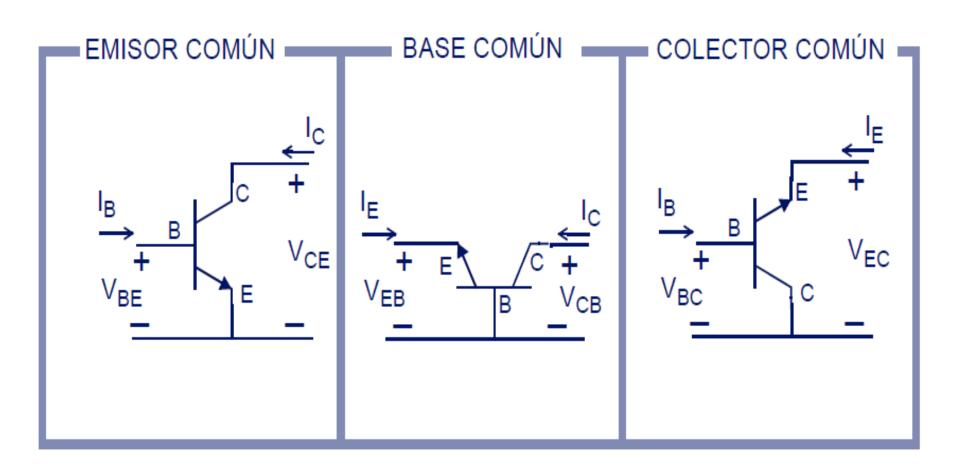
ZONA	CONDICIÓN		ECS DE CORRIENTE	
CORTE	VBE < Vf		lc= ie = ib = 0 A	Vf = 0.7 V
ACTIVA	V _{BE} > Vf	Vce > 0.2 V	Ic = β _F *I _B Ie = i _B (1 + β _F) Ie = ic*(1 + β _F) / β _F	V _{BE} = Vf Vf = 0.7 V
SATURADA	VBE > Vf	Ic < β _F *I _B	lc = le VcE = 0.2 V	V _{BE} = Vf Vf = 0.8 V
LIMITE ON-OFF	V _{BE} = V _F		Ic = IB = IE = 0 A VBE = Vf VF = 0.7 V	
LIMITE ACTIVA SATURACIÓN	Ic ≒ β _F *I _B		Ic = le VcE = 0.2 V	V _{BE} = V _f V _F = 0.7 V

Estas ecuaciones son iguales para el BJT canal PNP, solo cambia dirección de corrientes

EQUIVALENTE CIRCUITAL DEL BJT

ZONA	CORTE	ACTIVA	SATURACION	
MODELO EQUIVALENTE NPN	B Ib = 0	B Ib Ic C Ic = βlb Ie E	Vbe-sat Vce-sat	
MODELO EQUIVALENTE PNP	B Ib = 0 Ic = 0 E	B lb- C C Ic = βlb le E	B Ib ⇔ C C Vbe-sat Vce-sat E E	

Tres configuraciones: BJT NPN

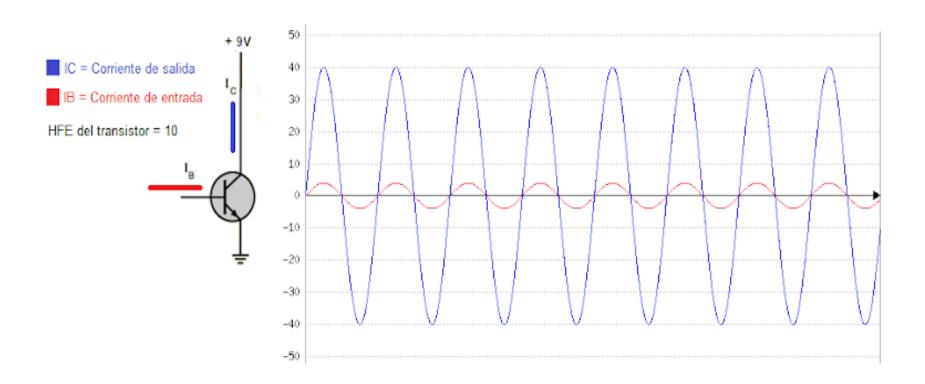


https://www.youtube.com/watch?v=dIV5l9cx_ck

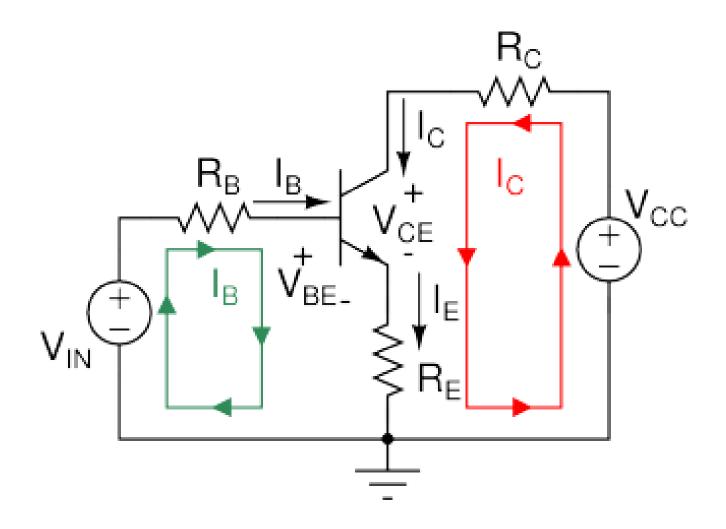
https://www.youtube.com/watch?v=7Q79fhvoRSs

https://www.youtube.com/watch?v=IVLwn-Iy6tU

https://www.youtube.com/watch?v=pfVUD5FVoB0



SENTIDO DE LAS CORRIENTES



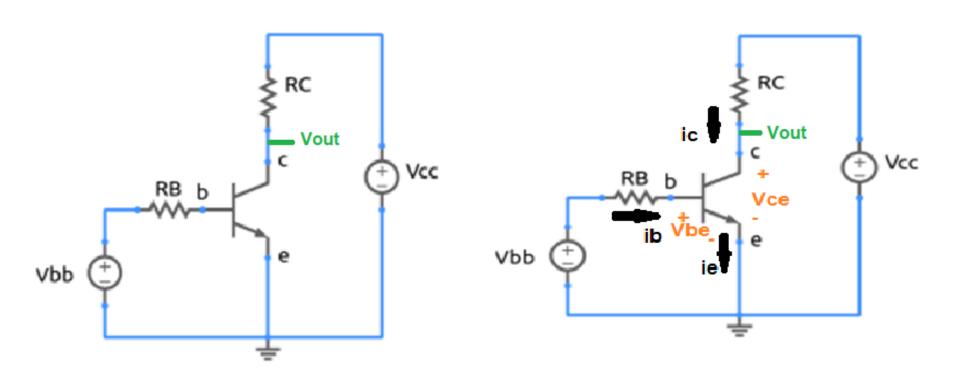
CIRCUITOS CON SEÑALES EN CORRIENTE DIRECTA

INVERSOR BJT O EMISOR COMÚN NPN

En esta configuración se tiene ganancia tanto de tensión como de corriente.

Para todo análisis circuital con transistores, se le deben identificar las corrientes y voltajes tal cual como se observa en la figura. Recuerda que el sentido y polaridad los indica la

flecha que tiene el transistor.

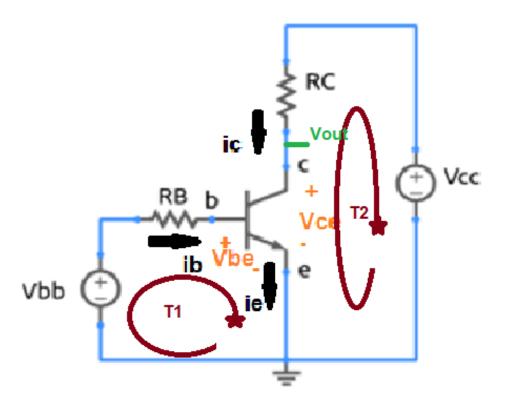


Una vez identificadas las corrientes y voltajes se procede a colocar la trayectoria de entrada y salida del circuito y luego aplicar LKV a cada trayectoria.

LKV T1
- Vbb + Rb*ib + Vbe = 0

LKV T2
- Vce - Rc*Ic + Vcc = 0

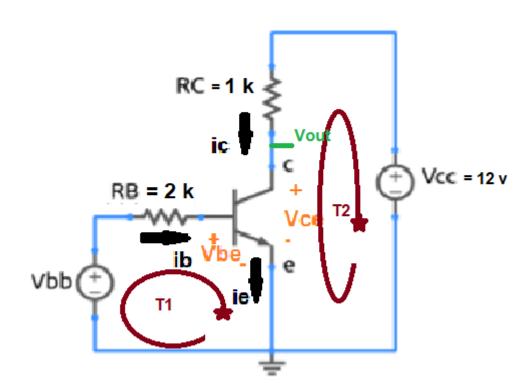
Luego se procede a obtener el voltaje de salida del inversor Vout



Definidas las ecuaciones procedemos a aplicar voltejes y definir zonas de trabajo en que deseamos trabaje el transistor.

Lo primero es conocer los limites del circuito encendido apagado y el limite entre activa y saturada. Para ello solo se define la cantidad de corriente que se quiere controlar y escoger una resistencia comercial. Para una corriente de 12 mA escogemos una resistencia de 1 k. Como V = i*R,

Note que no se coloca valores en Vbb debido a que se buscara el rango de voltaje que debe aplicarse a la base para que cumpla los limites.



ZONA LIMITE ENCENDIDO APAGADO

Según la tabla en esta zona el Vbe = Vf = 0,7 v lc = Ie = ib = 0 A

LKV T1

- Vbb + Rb*ib + Vbe = 0
- Vbb + 2*0 + 0,7 = 0

Vbb = 0.7 v

Este es el valor que debe tener la entrada VILL nor avo

el circuito encienda el transistor.

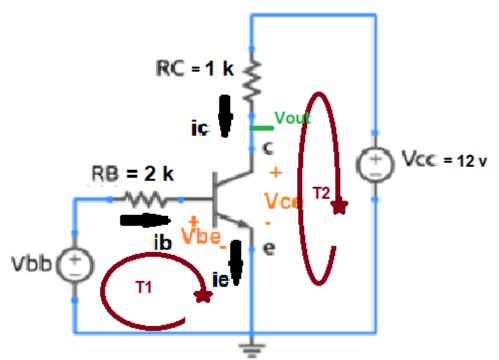
LKV T2

- Vce Rc*Ic + Vcc = 0
- Vce 1*0 + Vcc = 0

Vce = Vcc = 12 v

Este es el valor del Vce en este estado.

Luego se procede a obtener el voltaje de salida Vout



ZONA LIMITE ACTIVA SATURADO

Según la tabla en esta zona el Vce = 0,2 v Vf = 0,7 v Ic = Ie ic >= B*ib

Para este caso se debe iniciar con la ecs de la T2.

LKV T2

- Vce Rc*Ic + Vcc = 0
- -0.2 1*ic + 12 = 0

ic = 12-0,2 / 1k = 12 mA

LKV T1

- Vbb + Rb*ib + Vbe = 0
- Vbb + 2*ib + 0,7 = 0

$$ib = (Vbb - 0,7) / 2k$$

Ahora procedemos a utilizar la condición

$$Ic = B*ib$$

El B lo entrega el fabricante y en este caso

$$12mA = 30*(Vbb - 0,7) / 2k$$

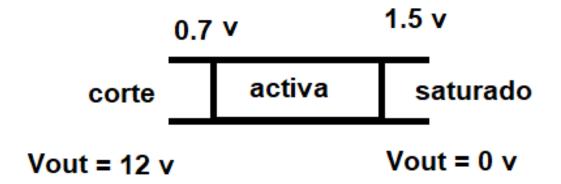
optamos por B = 30

$$Vbb = 1,5 v$$

Luego se procede a obtener el voltaje de salida Vout

Vout =
$$Vcc - Rc*Ic = 12 - 1*12$$

Vout =
$$0 v$$



Como se observa el transistor puede trabajar como interruptor, encendiendo la carga conectada a Vout en corte y apagándola en limite saturado.

Ahora procedemos a escoger valores de Vbb y comprobamos la zona en que se encuentra.

Zona Corte

Asumo Vbb = -1 v En esta zona ic=ib=ie= 0A

LKV T1

$$- Vbb + Rb*ib + Vbe = 0$$

$$-(-1) + Rb*0 + Vbe = 0$$

$$Vbe = -1 v$$

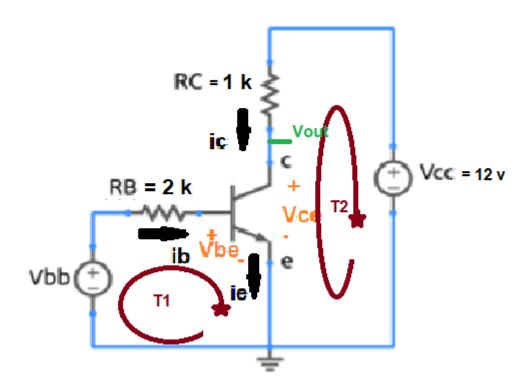
La condición dice Vbe < Vf

-1<0,7 v si cumple condición y se encuentra en la zona corte.

LKV T2

$$- Vce - Rc*Ic + Vcc = 0$$

$$Vce = 12 v$$



Luego se procede a obtener el voltaje de salida del inversor Vout

$$- Vout - Rc*Ic + Vcc = 0$$

Vout =
$$12 - 1*0 = 12 v$$

Zona Activa

Asumo Vbb = 1 v En esta zona ic=Bib, le = ib(B+1), Vbe = Vf = 0.7 v

LKV T1

$$- Vbb + Rb*ib + Vbe = 0$$

$$-(1) + 2*ib + 0.7 = 0$$

$$ib = 0,15 \text{ mA}$$

$$Ic = Bib = 30*0,15 = 4,5 \text{ mA}$$

$$Ie = ib(B+1) = 4,65 \text{ mA}$$

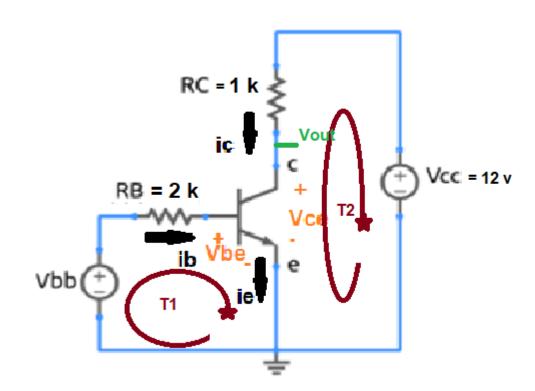
LKV T2

$$- Vce - Rc*Ic + Vcc = 0$$

$$- Vce - 1*4.5 + 12 = 0$$

$$Vce = 7,5 v$$

Procedo a verificar condición Vce > 0,2 v 7,5 > 0,2 v cumple condición



Vout

- Vout - Rc*Ic + Vcc = 0
Vout =
$$12 - 1*4,5 = 7,5 \text{ v}$$

La potencia en el transitor será:

$$PQ = vce*ic = 7,5*4,5 = 33,75 \text{ mW}$$

Se debe verificar con las especificaciones del fabricante que no supere esta potencia

Zona Saturada

Asumo Vbb = 3 v En esta zona ic = Ie, Vbe = 0,8 v

LKV T1

$$- Vbb + Rb*ib + Vbe = 0$$

$$-(3) + 2*ib + 0.8 = 0$$

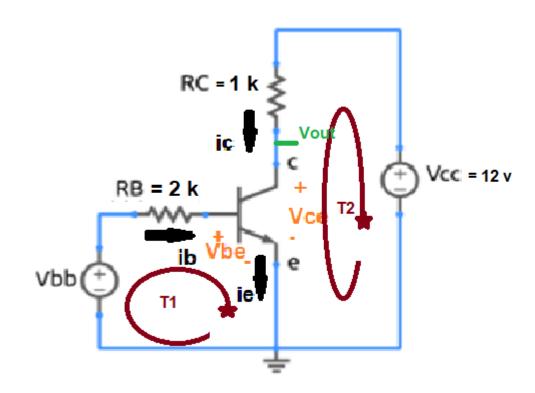
LKV T2

$$- Vce - Rc*Ic + Vcc = 0$$

$$-0.2 - 1*ic + 12 = 0$$

$$Ic = 11,8 \text{ mA}$$

Procedo a verificar condición Ic < B*ib 11,8 < 30*1,1 cumple condición



Vout

La potencia en el transitor será:

$$PQ = vce*ic = 0,2*11,8 = 2,32 \text{ mW}$$

Ganancia del inversor

La ganancia se escribe con la letra Av, en otrol libros G, H se define como la derivada del voltaje de salida respecto al de entrada.

$$Av = dVo / dVi = dVo / dVbb$$

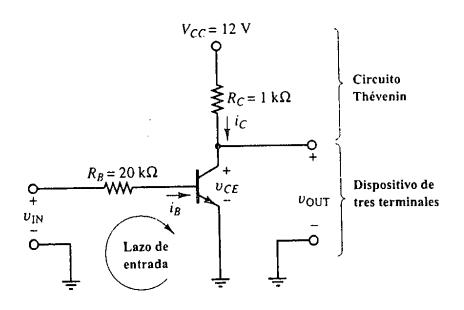
$$Av = dVo / dVbb$$

$$= d[vcc - (B*(vbb - vbe)/rb)*Rc] / dVbb$$

$$= [0 - (B*(1-0)/rb)*Rc]$$

$$Av = - B*Rc/Rb$$

El inversor de la figura 6.4 utiliza un BJT npn con $\beta_F = 100$ y $V_f = 0.6$ V como su dispositivo activo. Determine el voltaje de salida cuando $v_{\rm IN} = 1$ V, el cambio del voltaje de salida si $v_{\rm IN}$ se incrementa a 2V, y la característica de transferencia entrada-salida del inversor.



$$Vc - Vce - Ic*Rc = 0$$

 $Vce = Vc - Ic*Rc = 12 - 2mA*1K\Omega = 10 V$
 $Vce = Vout$
 $Como Vce >= Vcesat$
 $10v >= 0,2 Cumple y esta en zona activa.$

Como Vi >= Vf , Zona Conducción

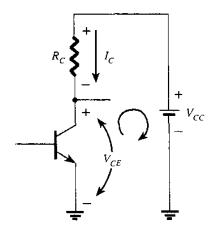
$$i_B = \frac{v_{\rm IN} - V_f}{R_B}$$

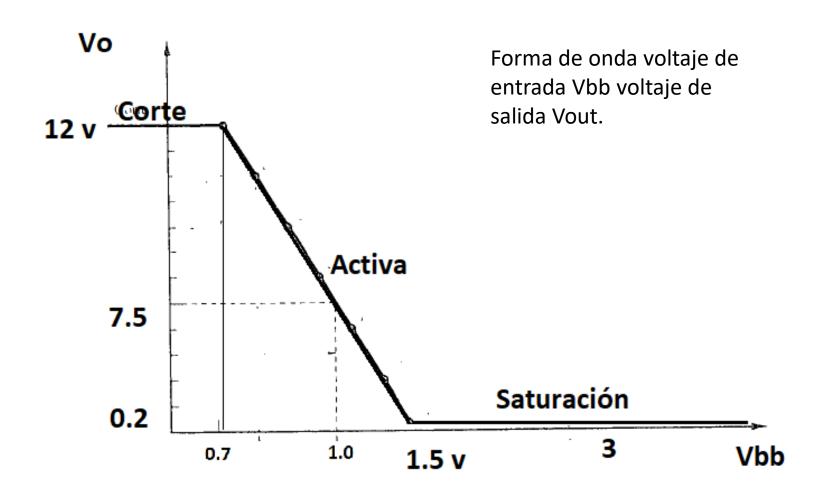
$$i_B = \frac{1 \, \text{V} - 0.6 \, \text{V}}{20 \, \text{k} \, \Omega} = 20 \, \mu \text{A}$$

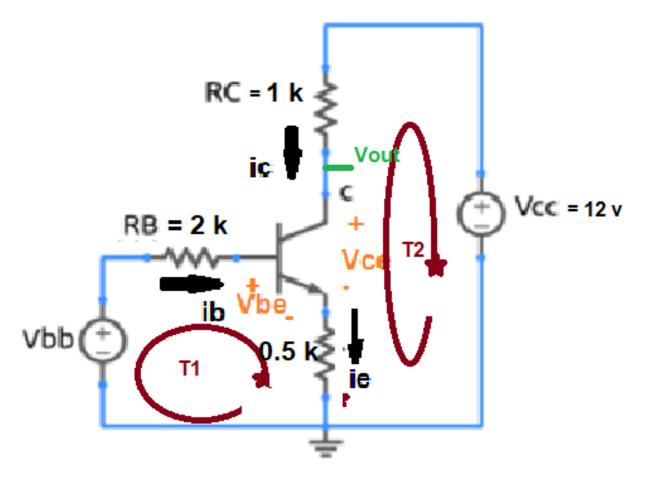
Me ubico en la zona activa

$$i_C = \beta_f i_B$$

= (100)(20 μ A) = 2 mA







$$-0.5ie - Vce - 1*ic + Vcc = 0$$

Limite activa sat ic = ie, Vce = 0.2 v, Vbe = 0.7 v T2

$$- 0.5ie - Vce - 1*ic + Vcc = 0$$

$$-0.5ic - 0.2 - 1*ic + 12 = 0$$

$$ic = 7.86 \text{ mA} = ie$$

T1
- Vbb + 2ib + Vbe + 0.5ie = 0
- Vbb + 2ib + 0.7 + 0.5*7.86 = 0
ib = (Vbb - 3.9) / 2

0.7 4.42 corte activa saturado

Zona Corte

En esta zona ic=ib=ie= 0A

T1

T2

$$-0.5ie - Vce - 1*ic + Vcc = 0$$

Asumo Vbb = 0,5 v -0,5 + 2*0 + Vbe + 0.5*0 = 0 Vbe = 0,5 v

La condición dice Vbe < Vf 0,5 <0,7 v si cumple condición y se encuentra en la zona corte.

LKV T2

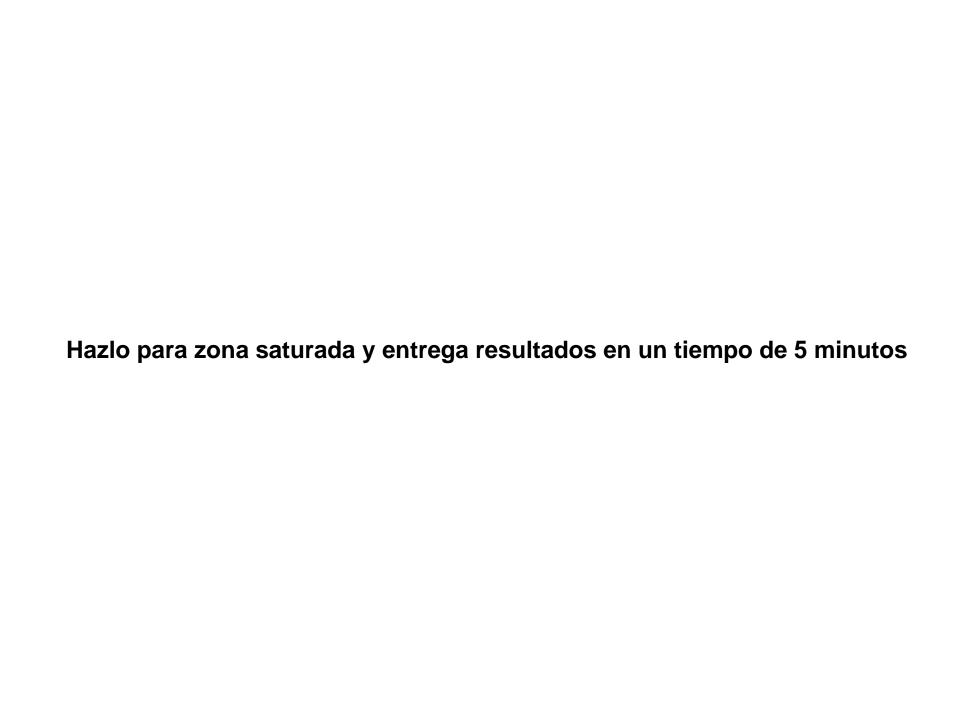
Vout = Vcc - Rc*Ic Vout = 12 - 1*0 = 12 v

Zona activa

Asumo Vbb = 3 v En esta zona ic=Bib, Ie = ib(B+1), Vbe = Vf = 0,7 v T1 - Vbb + 2ib + Vbe + 0.5ie = 0

T2

Vout = Vcc - Rc*Ic = **12 - 1*3,9 = 8,1 v**



COLECTOR COMÚN O SEGUIDOR DE EMISOR NPN

$$- Vbb + vbe + re*ie = 0$$

$$-re*ie - vce + vcc = 0$$

En corte ie=ib=ic= 0 A

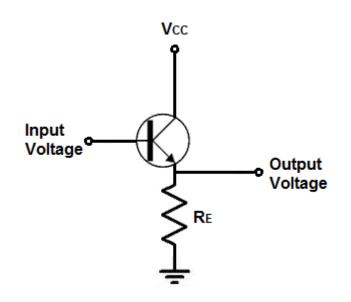
$$- Vbb + vbe + re*ie = 0$$

- Vbb + vbe +
$$re^*0 = 0$$

Vbb = vbe

-
$$re^*ie - vce + vcc = 0$$

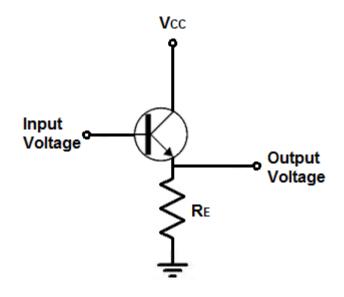
$$Vo = 0 v$$



Lo contrario al inversor en Vo

SEGUIDOR DE EMISOR NPN

En limite saturación activa ie=ic, Vce = 0,2



La ganancia de voltaje de un seguidor emisor es exactamente un poco menos de uno.

Su función no es la ganancia de voltaje, sino la ganancia de corriente o potencia, y la adaptación de impedancias

SEGUIDO DE EMISOR PNP

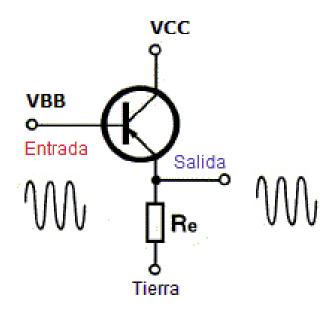
$$- Vbb - Vf - Vre = 0$$

Vre $= Vbb - Vf$

Como Vre = Vout Vout = Vbb - Vf

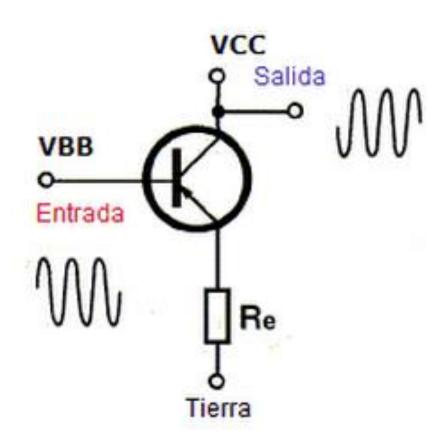
Si vf=0 ideal Vo = Vbb

Esto nos muestra que la señal de salida es la misma de la entrada



EMISOR COMÚN PNP

Realizarlo en su tiempo independiente



BASE COMÚN

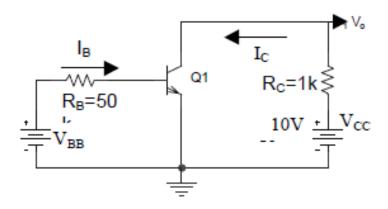
En esta configuración, la señal de entrada ingresa por el Emisor y la señal de salida Sale por el Colector, tiene como característica principal de tener una muy buena amplificación de tensión y de frecuencia.

Posee una impedancia de entrada muy baja, como se puede ver la base esta conectada a tierra por eso es el terminal común La corriente de base es cero y por ende ic = ie.

En el circuito de la fig. el transistor tiene una $\beta = 60$. Expresar los valores posibles de V_{BB} para que el transistor se encuentre:

- a) Zona de corte
- b) Zona activa.
- c) Zona de saturación.
- d) Si V_{BB} = 5 Voltios y manteniendo el valor de R_C = 1 K. ¿ entre que valores puede variar R_B para que el transistor se encuentre en la zona de activa?
- e) Si V_{BB} = 5 Voltios y manteniendo el valor de R_B = 50 K. ¿ entre que valores puede variar R_C para que el transistor se encuentre en la zona de saturación?

(VBE activa=0.7 Voltios, VCEsatuación=0.2 Voltios, VBE saturación=0.8 Voltios,



a) Zona de corte

La condición de corte ocurre cuando Vi < Vf; en este caso cuando Vi<0,7 v

 b) y c) Aquí vamos a ver para que tensión V_{BB} estará en saturación, luego entre el valor de corte y saturación estará la zona activa.

Si $I_{Csat} \leq \beta \cdot I_{Bsat}$ el dispositivo está en saturación en caso contrario en la zona activa.

$$I_{\textit{Csat}} = \frac{V_{\textit{CC}} - V_{\textit{CEsat}}}{R_{\textit{C}}} = \frac{10 - 0.2}{1} = 9.8 \textit{mA} \qquad \qquad I_{\textit{Bsat}} = \frac{V_{\textit{BB}} - V_{\textit{BEsat}}}{R_{\textit{B}}} = \frac{V_{\textit{BB}} - 0.8}{50}$$

Luego tenemos
$$9.8 \le \frac{V_{BB} - 0.8}{50} \cdot 60$$
 $V_{BB} \ge \frac{9.8 \cdot 50}{60} + 0.8 = 8.97 voltios$

Entonces para $0.7 \le V_{BB} \le 8.97 Voltios$ el transistor estará en zona activa.

 $V_{BB} \ge 8.97 voltios$ el transistor estará en saturación.

d) En este caso la zona de corte no varía, solo varían las zonas de saturación y activa. Calcularemos la zona de saturación para saber la zona activa.

 $I_{Csat} \leq \beta \cdot I_{Bsat}$ zona de saturación

$$I_{\textit{Csat}} = \frac{V_{\textit{CC}} - V_{\textit{CEsat}}}{R_{\textit{C}}} = \frac{10 - 0.2}{1} = 9.8 \textit{mA} \qquad \qquad I_{\textit{Bsat}} = \frac{V_{\textit{BB}} - V_{\textit{BEsat}}}{R_{\textit{B}}} = \frac{5 - 0.8}{R_{\textit{B}}}$$

$$9.8 \le \frac{5 - 0.8}{R_B} = \frac{4.2}{R_B} \cdot 60$$
 $R_B \le \frac{4.2}{9.8} \cdot 60 = 25.71K.$

Luego cuando RB sea mayor que 27,71 K el transistor va a estar en la zona activa.

 e) En este caso la zona de corte no varía solo varían las zonas de saturación y activa. Calcularemos la zona de saturación..

 $I_{Csat} \leq \beta \cdot I_{Bsat}$ zona de saturación

$$I_{\textit{Csat}} = \frac{V_{\textit{CC}} - V_{\textit{CEsat}}}{R_{\textit{C}}} = \frac{10 - 0.2}{R_{\textit{C}}} = \frac{9.8}{R_{\textit{C}}} \quad ; \qquad \quad I_{\textit{Bsat}} = \frac{V_{\textit{BB}} - V_{\textit{BEsat}}}{R_{\textit{B}}} = \frac{5 - 0.8}{50} = 0.084 \textit{mA}$$

$$\frac{9.8}{R_C} \le 0.084.60$$
; $R_C \ge \frac{9.8}{5.04} = 1.94 k\Omega$

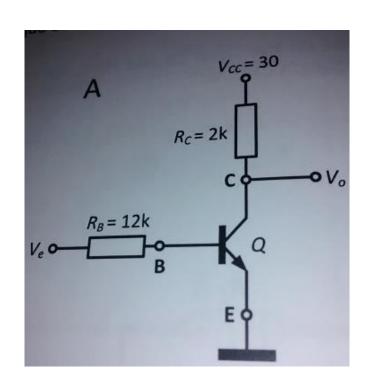
Luego cuando $R_C \le 1.94K\Omega$ el transistor estará en la zona activa.

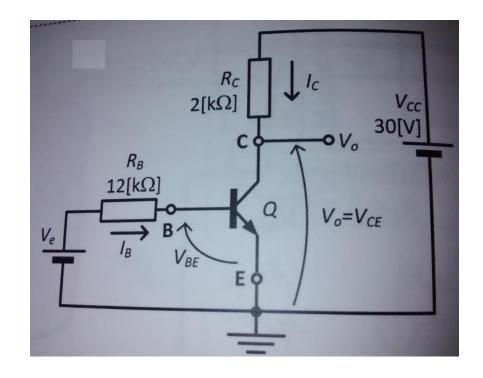
Para la figura, Q es un transistor bipolar NPN con una β = 50, Calcular Vo para

Ve = 0 v

Ve = 3 v

Ve = 12 v





En la practica el comportamiento del transistor para Vbe se tiene los siguientes casos:

- 1. Si Vbe < VbeY = 0.5 v, Q esta en corte (No conduce); Ib = Ic = 0; VbeY = Tensión de umbral.
- 2. Si Vbe > Vbe Υ = 0,5 v ; el transistor esta conduciendo, lb \neq 0 e lc \neq 0; en este caso puede estar en dos zonas:
 - a. Zona activa. Vbe = VbeAct = 0.7 v, ic = β ib, Ganancia de corriente, Adicional Vce >= VceSat Vcesat = 0.2 v
 - b. Zona saturación. Vbe = Vbe sat = 0.8 v, Vce = Vcesat = 0.2 v, Ic sat $\leq \beta ib_{sat}$

Para Ve = 0 v

Ve – Ib*Rb – Vbe = 0 Si Ve = 0 \rightarrow Ib = 0, Vbe = 0 v; cumpliendo Vbe < VbeY = 0,5 v, Q esta en corte Ic = 0

Vcc - Ic*Rc - Vce = 0; Vcc = Vce = Vo = 30v

Ve = 3 v

Para este caso Vbe = Ve = 3 v > VbeY > 0.5 vesta condición tiene a Q en conducción en una de las dos zonas

Supongamos que Q esta en la zona activa, reemplazamos el Q por el equivalente

de la zona activa.

En la zona activa Vbe = VbeAct = 0,7 v

Ve -
$$lb*Rb - Vbe = 0$$

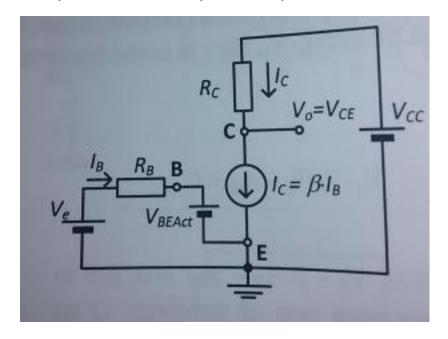
 $lb = 3 - 0.7 / 12000 = 0,192 \text{ mA}$

$$ic = \beta ib$$
; $Ic = 50* 0,192 \text{ mA} = 9,58 \text{ mA}$

$$Vcc - Ic*Rc - Vce = 0$$

 $Vce = 30 - 9,58*2 = 10.8 v$

Ahora corroboramos si esta o no en esta zona



Ve = 12 v

Para este caso Vbe = $Ve = 12 \text{ v} > Vbe\Upsilon > 0.5 \text{ v}$ esta condición tiene a Q en conducción en una de las dos zonas

Supongamos que Q esta en la zona activa, reemplazamos el Q por el equivalente de la zona activa.

$$Ve - Ib*Rb - Vbe = 0$$
; $Ib = 12 - 0.7 / 12000 = 0,941mA$

ic =
$$\beta$$
ib ; Ic = $50* 0.941 \text{ mA} = 47.08 \text{ mA}$

$$Vcc - Ic*Rc - Vce = 0$$
; $Vce = 30 - 47,08*2 = -64,16 v$

Ahora corroboramos si esta o no en esta zona Vce > Vcesat = 0.2 v - 64,16 v >= 0.2 v No Cumpliendo la condición, el Q esta en la zona de Saturación

$$Vcc - Ic*Rc - Vce = 0$$

Icsat =
$$14.9 \text{ mA}$$

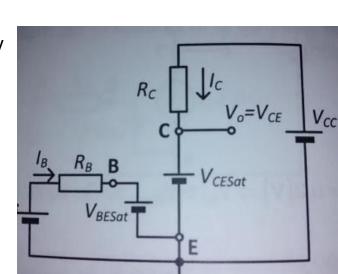
Como esta en saturación debo recalcular IbSat ya que VbeSat = 0,8 v

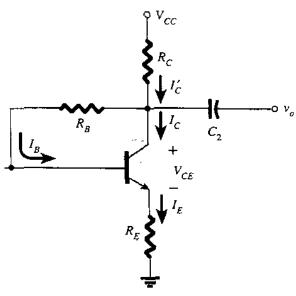
$$Ve - Ib*Rb - Vbe = 0$$
; $Ib = 12 - 0.8 / 12000 = 0,933 mA$

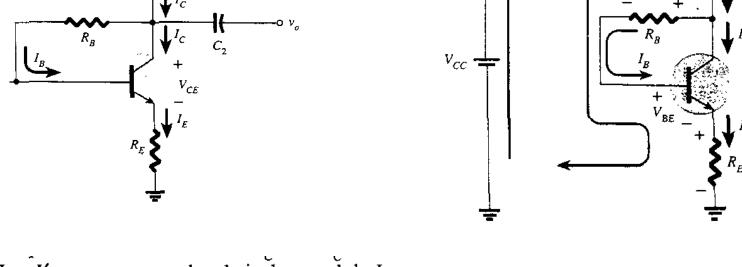
Ahora comprobamos la condición Ic ≤ βib

$$14.9 \text{ mA} \leq 50*0.933 \text{ mA}$$

$$Vo = Vce = 0.2 v$$







 I_C e I_C' supera por mucho el nivel normal de I_B

$$\begin{split} I_C' &\cong I_C = \beta I_B \, \mathbf{e} \, I_E \cong I_C \\ V_{CC} &- \, \beta I_B R_C \, - \, I_B R_B \, - \, V_{BE} \, - \, \beta I_B R_B \, = \, 0 \\ V_{CC} &- \, V_{BE} \, - \, \beta I_B (R_C \, + \, R_E) \, - \, I_B R_B \, = \, 0 \end{split}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta (R_C + R_E)}$$

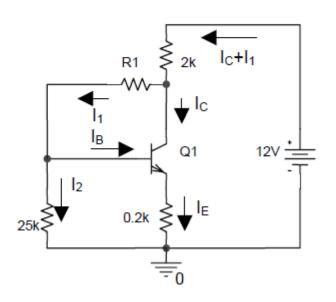
La malla colector-emisor

$$I_{E}R_{E} + V_{CE} + I'_{C}R_{C} - V_{CC} = 0$$

$$I_{C}(R_{C} + R_{E}) + V_{CE} - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_{C}(R_{C} + R_{E})$$

1.2.- En el circuito de la figura si $\alpha = 0.98$ y $V_{BE} = 0.7$ Voltios, calcular el valor de la resistencia R_{I} , para una corriente de emisor 2 mA



$$R_{1} = \frac{V_{C} - V_{B}}{I_{1}}$$

$$\downarrow^{l_{C}}$$

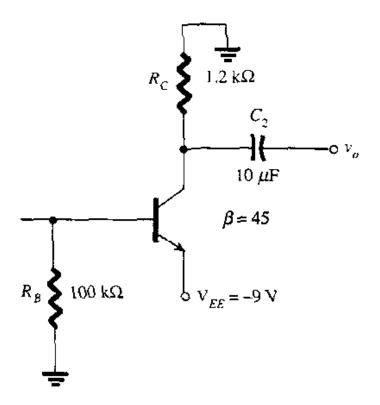
$$I_{C} = \alpha \cdot I_{E} = 0.98 \cdot 2 = 1.96 mA$$

$$I_{B} = I_{E} - I_{C} = 2 - 1.96 = 0.04 mA$$

$$\begin{split} V_B &= V_{BE} + I_E \cdot R_E = 0.7 + 2 \cdot 0.2 = 1.1 Voltios & I_2 = \frac{V_B}{25} = \frac{1.1}{25} = 0.044 mA \\ I_1 &= I_B + I_2 = 0.04 + 0.044 = 0.084 mA \\ V_C &= V_{CC} - (I_C + I_1) \cdot 2 = 12 - (1.96 + 0.084) \cdot 2 = 7.912 Voltios \\ R_1 &= \frac{V_C - V_B}{I_1} = \frac{7.912 - 1.1}{0.084} = 81.1 K \end{split}$$

el transistor está en la zona activa por tener V_{CE}> 0.2 V

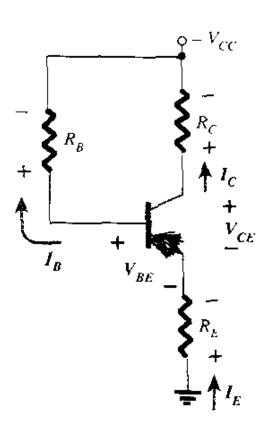
 $V_{CE} = V_{C}-V_{E}=7.912-2.0.2=7.512$ Voltios



$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B} = \frac{9 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 83 \text{ } \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_{E} = (45)(83 \ \mu = 3.735 \ \text{mA}$$

$$V_C = -I_C R_C$$
 $V_B = -I_B R_B$
= -(3.735 mA)(1.2 k Ω) = -(83 μ A)(100 k Ω)
= -4.48 V = -8.3 V

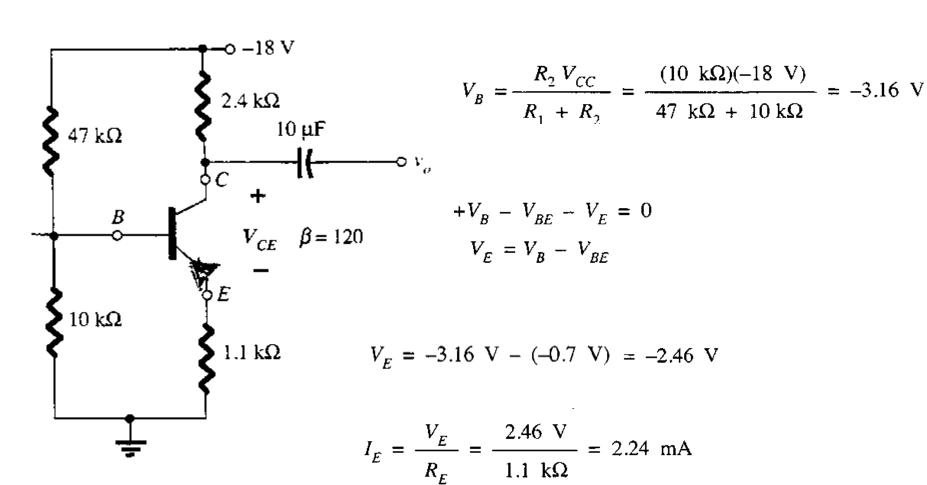


$$-I_{\mathcal{E}}R_{\mathcal{E}} + V_{B\mathcal{E}} - I_{\mathcal{B}}R_{\mathcal{B}} + V_{CC} = 0$$

$$I_{\mathcal{B}} = \frac{V_{CC} + V_{\mathcal{B}\mathcal{E}}}{R_{\mathcal{B}} + (\beta + 1)R_{\mathcal{E}}}$$

$$-I_{E}R_{E} + V_{CE} - I_{C}R_{C} + V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = -V_{CC} + I_{C}(R_{C} + R_{E})$$

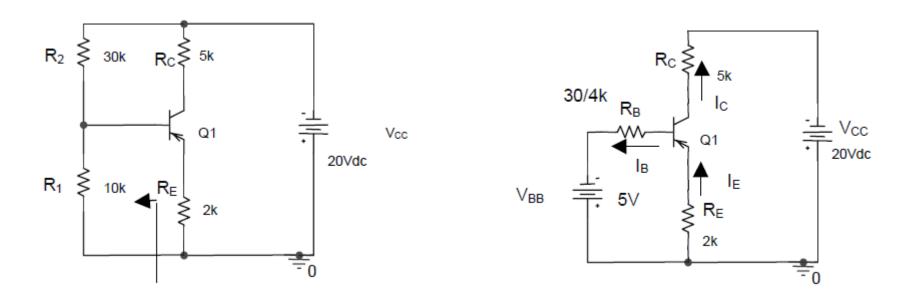


$$-I_E R_E + V_{CE} - I_C R_C + V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = -V_{CC} + I_C (R_C + R_E)$$

$$= -18 \text{ V} + (2.24 \text{ mA})(2.4 \text{ k}\Omega + 1.1 \text{ k}\Omega) = -10.16 \text{ V}$$

3.2.- El circuito de la figura con un transistor PNP tiene un $\beta = 100$, $V_{BE} = -0.7V$. Calcular todas las intensidades y tensiones en los diferentes puntos.



Lo primero que hay que hacer es el thevenin, desde la base del transistor hacia la izquierda, quedando el circuito de la figura de la derecha:

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} \cdot R_1}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 10}{10 + 30} = 5V \qquad \qquad R_{BB} = \frac{R_2 \cdot R_1}{R_1 + R_2} = \frac{30 \cdot 10}{10 + 30} = \frac{30}{4} K\Omega.$$

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + I_E \cdot R_E - V_{BE} = I_B \cdot R_B + (\beta + 1) \cdot I_B - V_{BE}$$
 despejando I_B se tiene:

$$I_B = \frac{V_{BB} + V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) \cdot R_E} = \frac{5 - 0.7}{\frac{30}{4} + (100 + 1) \cdot 2} = \frac{4.3 \cdot 4}{838} = \frac{8.6}{419} = 0.021 mA$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = \frac{100 \cdot 8.6}{419} = \frac{860}{4.19} = 2.05 mA$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = \frac{101 \cdot 8.6}{419} = 2.07 mA$$

$$V_C = I_C \cdot R_C - V_{CC} = 2.05 \cdot 5 - 20 = -9.75V$$

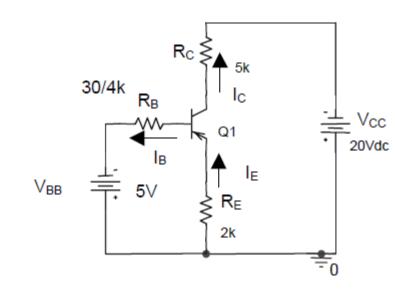
$$V_{\text{F}} = -I_{\text{F}} \cdot R_{\text{F}} = -2.07 \cdot 2 = -4.14V$$

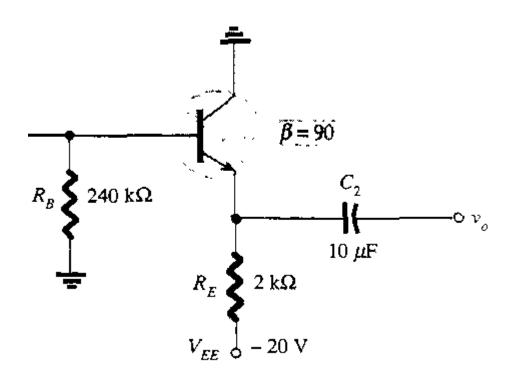
$$V_{CE} = V_C - V_E = -9.75 - (-4.14) = -5.61V$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = -0.7 - 4.14 = -4.84V$$

Para la resistencia
$$R_1$$
 $I_1 = \frac{0 - V_B}{R_1} = \frac{4.84}{10} = 0.48 mA$.

Para la resistencia R_2 $I_2 = I_1 + I_2 = 0.48 + 0.02 = 0.50 \text{ mA}$.





$$V_{EE} - V_{BE} - (\beta + 1)I_B R_{E_c} - I_B R_B = 0$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$= \frac{20 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega + (91)(2 \text{ k}\Omega)} = 45.73 \text{ } \mu\text{A}$$

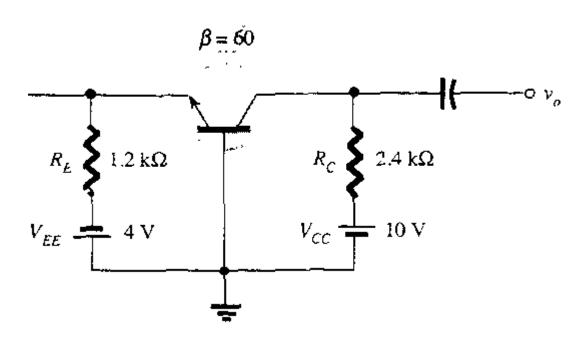
$$I_C = \beta I_B = 4.12 \text{ mA}$$

$$-V_{EE} + I_{E}R_{E} + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE_{Q}} = V_{EE} - (\beta + 1)I_{B}R_{E}$$

$$= 20 \text{ V} - (91)(45.73 \,\mu\text{A})(2 \text{ k}\Omega)$$

$$= 11.68 \text{ V}$$



$$-V_{EE} + I_{E}R_{E} + V_{BE} = 0$$

$$I_{E} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_{E}}$$

$$\frac{4 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.2 \text{ k}\Omega} = 2.75 \text{ mA}$$

$$-V_{CB} + I_{C}R_{C} - V_{CC} = 0$$

$$V_{CB} = V_{CC} - I_{C}R_{C} \text{ con } I_{C} \equiv I_{E}$$

$$= 10 \text{ V} - (2.75 \text{ mA})(2.4 \text{ k}\Omega) = 3.4 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2.75 \text{ mA}}{60} = 45.8 \mu A$$

Seguidor de corriente BJT (Amplificador de base común)

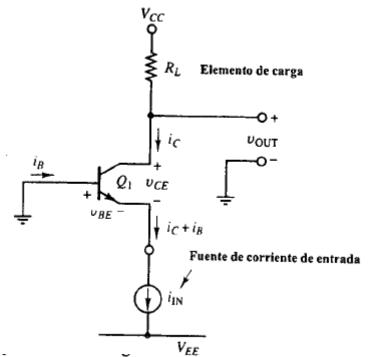
BJT operando en la región activa

$$i_B = \frac{i_{\rm IN}}{\beta_F + 1}$$

$$i_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} i_{\rm IN}$$

$$v_{\rm OUT} = V_{CC} - i_C R_L = V_{CC} - \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} R_L i_{\rm IN}$$

Para una β_F grande, la ecuación anterior se simplifica a $v_{\text{OUT}} \approx V_{CC} - R_L i_{\text{IN}}$



La transición al corte ocurre cuando $i_{IN} = 0$ y está acompañada por la condición $v_{OUT} = V_{CC}$ (no hay caída de voltaje a través de R_L).

BJT operando en la región de saturación

$$v_{\rm OUT} = -V_f + V_{\rm sat}$$
 $v_{\rm CE} = V_{\rm sat}$

$$Vf + V_{IN} + Vee = 0$$
; $Vee <<< Vf$
 $V_{IN} = -Vf$
 $-V_{IN} - Vsat + Vout = 0$

El valor de $v_{\scriptscriptstyle \rm IN}$ correspondiente a la entrada en saturación puede determinarse combinando las ecuaciones

$$v_{\text{OUT}} = V_{CC} - i_C R_L = V_{CC} - \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} R_L i_{\text{IN}}$$
 $v_{\text{OUT}} = -V_f + V_{\text{sat}}$

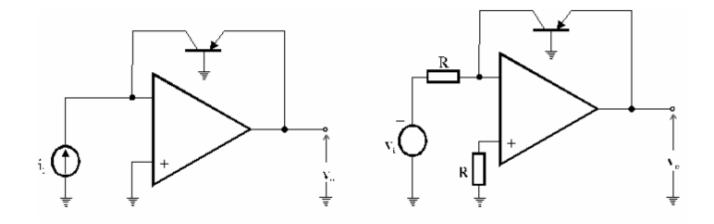
$$V_{\text{sat}} - V_f = V_{CC} - \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} R_L i_{\text{IN-sat}}$$

$$i_{\text{IN-sat}} = \frac{V_{CC} - V_{\text{sat}} + V_f}{R_L} \frac{\beta_F + 1}{\beta_F}$$

$$i_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} i_{\rm IN}$$

$$i_{C-\text{sat}} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} i_{\text{IN-sat}} = \frac{V_{CC} - V_{\text{sat}} + V_f}{R_L}$$

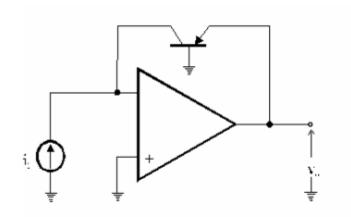
AMPLIFICADOR LOGARÍTMICO

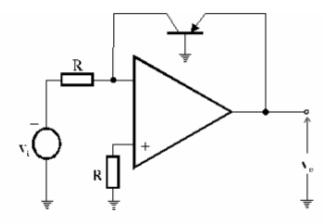


En la figura se muestra el amplificador logarítmico básico, basado en las características del transistor bipolar. a este circuito se le suele llamar configuración transdiodo.

La salida es siempre vbe, y el bucle de realimentación de alta ganancia introducido a través del amplificador operacional, obliga que la intensidad de colector en el transistor sea igual que la intensidad de entrada.

AMPLIFICADOR LOGARÍTMICO





$$-Ii - ic = 0$$

$$-Ii = is[exp(vo/n*vt) -1]$$

$$-(Ii /is) + 1 = exp(vo/n*vt)$$

- Logn(Ii /is) + 1 = Logn
$$exp(vo/n*vt)$$

$$id = is[exp(vd/n*vt) -1] 0 - vo + vbe = 0$$
$$= is[exp(vo/n*vt) -1] Vo = vbe$$

Amplificador Exponencial (Antilogarítmico)

le=ib+ic ib=0, ie=id.diodo
le= ic
$$0-vo+vbe=0$$

$$Vo=vbe$$

$$id=is[exp(vd/n*vt)-1]$$

$$=is[exp(vo/n*vt)-1]$$
AN Vn
$$-lc-(vn-Vo)/R1=0$$

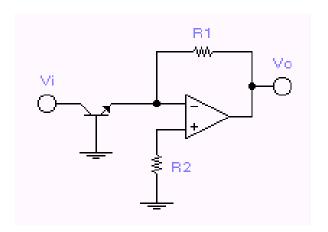
$$-lc-(0-Vo)/R1=0$$

$$-lc-Vo/R1=0$$

-Ic*R1 = Vo

- is[exp(vo/n*vt) -1]*R1 = Vo

Vo = -R1* is[exp(vo/n*vt) -1]



EFECTO EARLY

Una vez polarizado el transistor en su zona de funcionamiento se pueden producir variaciones no deseadas de las corrientes en el mismo debidas a variaciones en la tensión colector-base. Estas variaciones de corriente son consecuencia de la modulación de la anchura de la base, también conocida como Efecto Early.

FENÓMENOS DE AVALANCHA Y PERFORACIÓN

El transistor bipolar, como cualquier dispositivo en cuya estructura existan uniones PN polarizadas, tiene unas limitaciones físicas de funcionamiento debidas a los fenómenos de avalancha que se pueden producir al aplicar tensiones elevadas a las uniones.

CONSIDERACIONES SOBRE POTENCIA

La potencia disipada por cualquier componente viene dada por la ecuación: $P = V \cdot I$

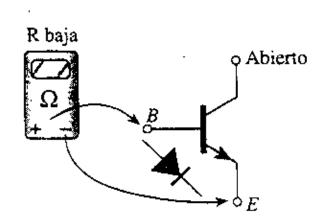
en el caso particular de un transistor bipolar

$$P = V_{CE} \cdot I_C$$

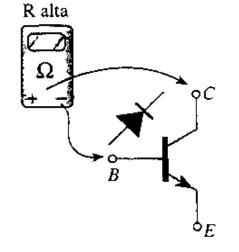
PRUEBA DE TRANSISTORES

Medidores digitales avanzados

Óhmetro



lectura que, por lo regular, caerá en el rango de 100Ω a unos cuantos kilohms.



lectura que suele exceder los $100 \text{ k}\Omega$.

TRABAJO GRUPAL BJT

Inversor BJT pág. 368 libro guía, ejercicios 6.1 al 6.24. Debe entregar 2

Seguidor de voltaje BJT pág. 374 libro guía, ejercicios 6.60 al 6.80. Debe entregar 2

Seguidor de corriente BJT pág. 379 libro guía, ejercicios 6.94 al 101 entregar 2 Configuración Cascode BJT pág. 380 libro guía ejercicios 6.102 al 6.106 entregar 2

Circuitos de polarización estabilizando emisor pág. 207 libro complementario, ejercicios del 6 y 9. Entrega 2. Circuitos de polarización por divisor de voltaje pág. 208 libro complementario, ejercicios del 12 al 14. Entrega 2.

Polarización por retroalimentación de voltaje pág. 209 libro complementario, ejercicios del 22 y 23. Entrega todos. **Diversas configuraciones** pág. 210 libro complementario , ejercicios del 27 al 31. Entrega todos.

Operación de diseño pág.. 210 libro complementario, ejercicios del 32 al 35. Entrega todos. **Transistores PNP** pág. 213 libro complementario, ejercicios del 44 al 46. Entrega todos.